


СВЕДЕНИЯ ОБ ОППОНЕНТЕ

по кандидатской диссертации Рогова Олега Юрьевича
 «Формирование и исследование хиральных фотонных наноструктур методами
 электронной и ионной микроскопии»
 по специальности 01.04.07– «Физика конденсированного состояния».

Фамилия, имя, отчество оппонента	Аронзон Борис Аронович
Дата рождения	09.02.1947
Шифр и наименование специальности, по которым защищена диссертация	01.04.07 - Физика конденсированного состояния
Ученая степень и отрасль науки	Доктор физико-математических наук
Ученое звание	
Полное наименование организации, являющейся основным местом работы оппонента	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук
Почтовый адрес с указанием индекса	119991 ГСП-1 Москва, Ленинский проспект, д.53, ФИАН
Занимаемая должность	Заведующий лабораторией физического материаловедения полупроводников
Телефон	8-916-831-19-01
Адрес электронной почты	aronzon@mail.ru
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет	<ol style="list-style-type: none"> 1. A. V. Kochura, L. N. Oveshnikov, A. P. Kuzmenko, A. B. Davydov, S. Yu. Gavrilkin, V. S. Zakhvalinskii, V. A. Kulbachinskii, N. A. Khokhlov, B. A. Aronzon, Vapor-phase synthesis and magnetoresistance of $(\text{cd}1-x\text{zn}x)3\text{As}_2$ ($x = 0.007$) single crystals // JETP Letters. — 2019., Т. 109, №. 3. С. 175–179. 2. L. Oveshnikov, L. Morgun, E. Nekhaeva, V. Kulbachinskii, B. Aronzon, Quantum effects in magnetotransport of InGaAs quantum wells with remote mn impurities // EPJ Web of Conferences. — 2018. Т. 185., С. 1-4. 3. Khramova O.D., Mikhalevsky V.A., Parshina L.S., Novodvorsky O.A., Marenkin S.F., Lotin A.A., Cherebilo E.A., Aronzon B.A., Aronov A.N., Panchenko V.Ya, Magnetoresistance of the p-(InSb + MnSb)/n-InSb diode structure // Optical and Quantum Electronics. — 2016. Т. 48, №. 7. 4. L. N. Oveshnikov, A. B. Davydov, V. A. Kulbachinskii, B. A. Aronzon, Study of the "metal-insulator" transition induced by the impurity fluctuation potential using the Shubnikov-de Haas effect // Bulletin of the Lebedev Physics Institute.- 2017. Т. 44 №.5 С. 143-146

5. L.N. Oveshnikov, V.A. Kulbachinskii, A.B. Davydov, B.A. Aronzon, Anomalous Hall effect in 2D DMS // Solid State Phenomena.- 2015. T. 233, C. №.10. C.109-112
6. L. N. Oveshnikov, V. A. Kulbachinskii, A. B. Davydov, B. A. Aronzon, I. V. Rozhansky, N. S. Averkiev, Berry phase mechanism of the anomalous Hall effect in a disordered two-dimensional magnetic semiconductor structure // Scientific Reports.- 2015. T. 5. №.11. C. 1-9

Дата: 03.10.2019

12 
(подпись)

д.ф.-м.н., Аронзон Б.А.

Подпись Аронзона Б.А. заверяю,
Ученый секретарь ФИАН
им. П.Н. Лебедева



к. ф.-.м.н. Колобов А.В.